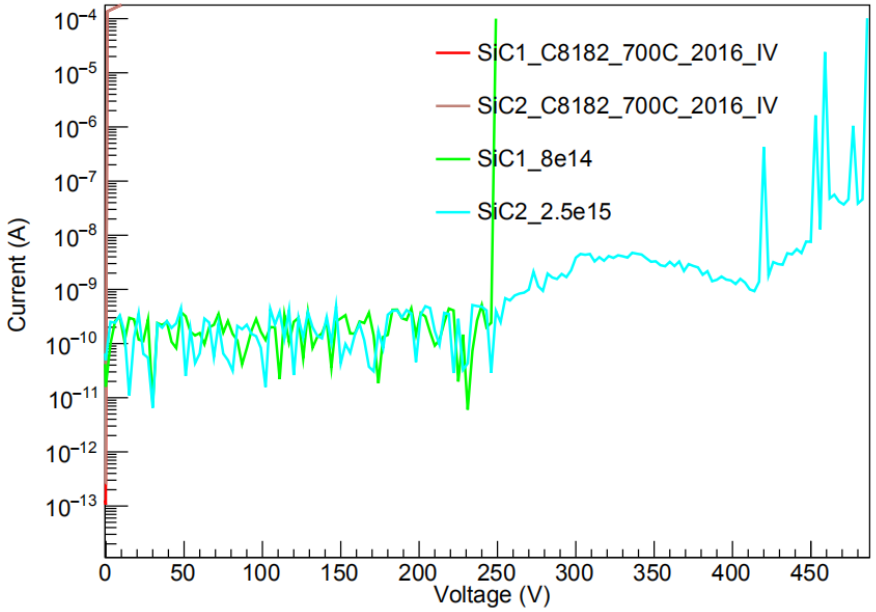
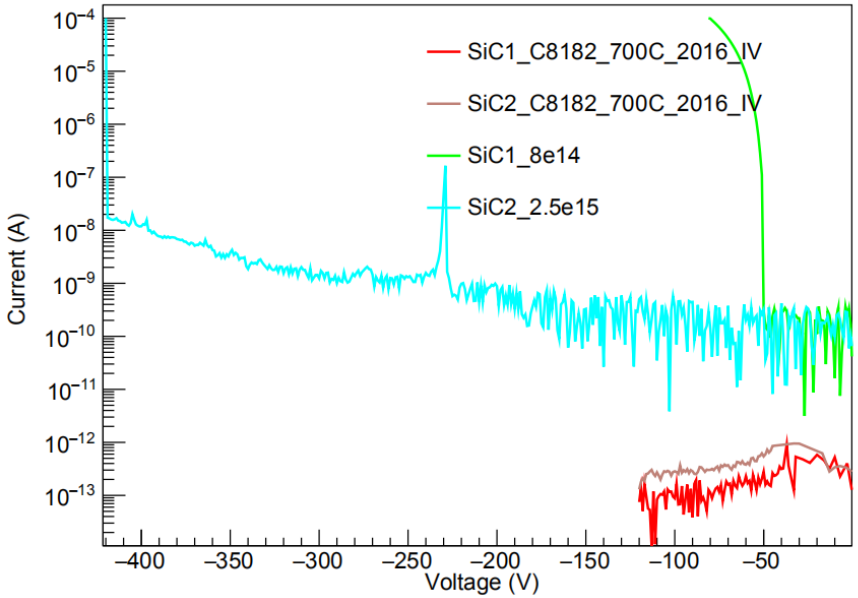
JSI irradiation measurement

IV 测试：

正偏



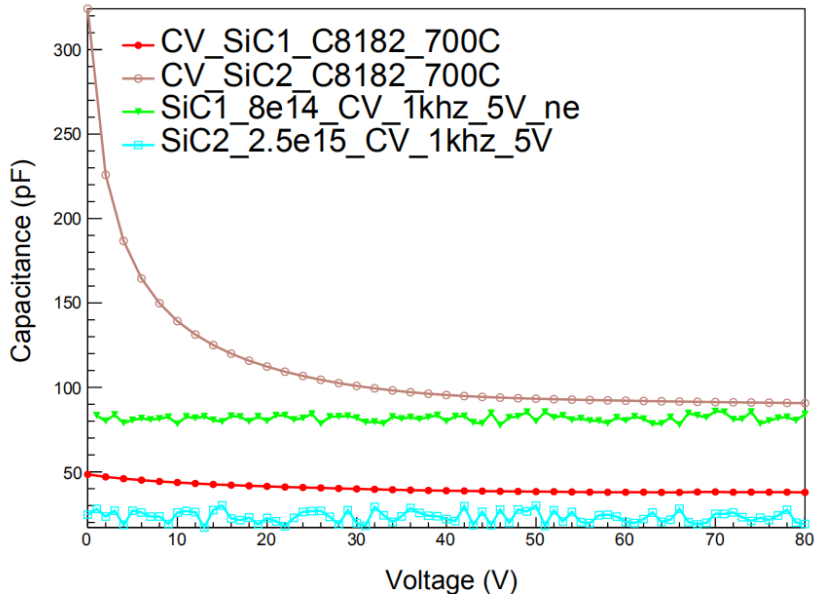
反偏



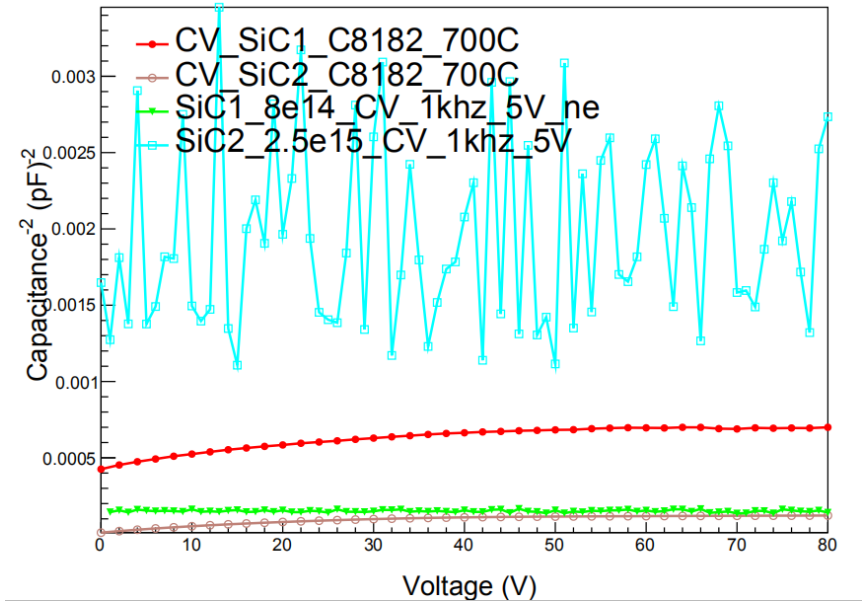
- 辐照令反偏电流从1e-12升到1e-10
- 正偏的“击穿电压”随辐照强度的增加而增加
- 正偏的“击穿电压”随辐照强度的增加先减小后增加？

CV 测试:

C-V



$1/C^2$ –V



- 辐照后，全耗尽电容都有一定程度的减小
- 辐照后，电容基本不变
- 2.5e15 辐照后，稳定性很差

下一步计划：

- 询问大连理工芯片结构，计算大概的电场
- 理解数据
- 尝试beta测试时间